

1. 形名 LSCR523EB FS8
2. 構造 NPN エピタキシャルプレーナ形シリコントランジスタ
3. 用途 一般小信号増幅
4. 絶対最大定格 [Ta=25°C]

コレクターベース間電圧 V_{CB0} . . . 50V

コレクターエミッタ間電圧 V_{CE0} . . . 50V

エミッターベース間電圧 V_{EB0} . . . 5V

コレクタ電流 I_C . . . 100mA

I_{CP} . . . 200mA (P_w=10mS 単発パルス)

許容損失 P_D . . . 150mW

* 各端子を推奨ランドに
実装した場合

ジャンクション温度 T_j . . . 150°C

保存温度 T_{stg} . . . -55~150°C

DESIGN



CHECK



APPROVAL



DATE : 8 / JLY / 2010

SPECIFICATION No. T837-LSCR523EB FS8

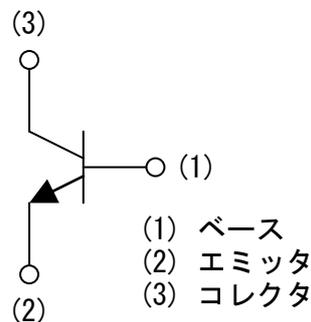
REV. : 0

ROHM Co.,Ltd.

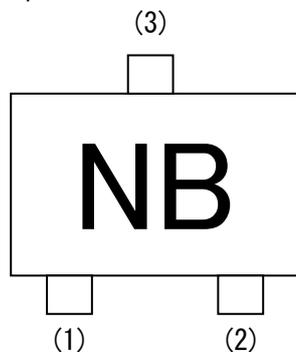
5. 電気的特性 [Ta=25°C]

| 項目 | 記号 | 条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 |
|----------------|---------------|--|-----|--------|------------|
| コレクター-エミッタ降伏電圧 | BV_{CE0} | $I_C=1mA$ | 50V | — | — |
| コレクター-ベース降伏電圧 | BV_{CBO} | $I_C=50\mu A$ | 50V | — | — |
| エミッター-ベース降伏電圧 | BV_{EBO} | $I_E=50\mu A$ | 5V | — | — |
| コレクタ遮断電流 | I_{CBO} | $V_{CB}=50V$ | — | — | $0.1\mu A$ |
| エミッタ遮断電流 | I_{EBO} | $V_{EB}=5V$ | — | — | $0.1\mu A$ |
| コレクター-エミッタ飽和電圧 | $V_{CE(sat)}$ | $I_C=50mA / I_B=5mA$ | — | 0.10V | 0.30V |
| 直流電流増幅率 | h_{FE} | $V_{CE}=6V / I_C=1mA$ | 120 | — | 560 |
| 利得帯域幅積 | f_T | $V_{CE}=10V / I_E=-10mA$ $f=100MHz$ | — | 350MHz | — |
| 出力容量 | C_{ob} | $V_{CB}=10V / I_E=0A$ $f=1MHz$ | — | 1.6pF | — |

6. 回路構成



7. 標 印



“ NB ” は、LSCR523EB FS8 を表す略記号です。

- (1) ベース
(2) エミッタ
(3) コレクタ